## МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ (ЧЕРНОГОЛОВКА)

УДК 547.73'148.2'112.1:548.75

# ОПТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АНИЗОТРОПИИ В ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОВОДНИКАХ D<sub>4</sub>[MBr<sub>4</sub>](Solvent)

© 2020 г. Е. И. Жиляева<sup>*a*,\*</sup>, Н. В. Дричко<sup>*b*</sup>, Г. В. Шилов<sup>*a*</sup>, А. М. Флакина<sup>*a*</sup>, С. А. Торунова<sup>*a*</sup>, Р. Н. Любовская<sup>*a*</sup>

<sup>а</sup> Российская академия наук, Институт проблем химической физики, Черноголовка, Московская обл., Россия <sup>b</sup> Университет Дж. Хопкинса, Балтимор, США

> \* *e-mail: zhilya@icp.ac.ru* Поступила в редакцию 17.07.2019 г. После доработки 17.07.2019 г. Принята к публикации 17.09.2019 г.

Изучены поляризованные спектры отражения и спектры оптической проводимости слоистых органических проводников  $D_4[MBr_4](Solvent): \theta - (BEDT-TTF)_4HgBr_4(DCB), \theta - (BEDT-TTF)_4Cd Br_4(DBB), \theta - (d_8-BEDT-TTF)_4CdBr_4(DBB) и \theta - (BETS)_4CdBr_4(PhBr) (DCB и DBB = o-дихлор- и о$ дибром-бензолы, BEDT-TTF и BETS – бис(этилендитио)тетратиа- и бис(этилендитио)тетраселена-фульвалены). Соседние проводящие слои этих соединений различаются направлением стопоккатион-радикалов (направления стопок взаимно перпендикулярны). Показано, что эти проводники характеризуются высокой изотропией электронной системы в проводящей плоскости и квазидвумерным характером электронной проводимости, что хорошо согласуется с кристаллическойструктурой.

*Ключевые слова:* молекулярные проводники, катион-радикальные соли, электропроводность, поляризованные спектры отражения, оптическая проводимость

DOI: 10.31857/S0044453720050313

Известно, что органические проводники на основе катион-радикальных солей при понижении температуры проявляют металлические свойства или подвергаются фазовым переходам в сверхпроводящее или диэлектрическое состояние [1, 2]. Как правило, слоистые органические проводники на основе катион-радикальных солей построены из проводящих слоев с одинаковым направлением стопок катион-радикалов во всех слоях [1]. С этим обычно связана наблюдаемая в плоскости слоев анизотропия проводимости и других свойств электронной системы.

Однако среди катион-радикальных солей со стопочной структурой проводящего слоя известно несколько соединений, для которых направления стопок в соседних проводящих слоях отличаются. К этому типу соединений относятся полученные нами ранее органические проводящими слоями [3] (EDT-TTF)<sub>3</sub>Hg<sub>2</sub>Br<sub>6</sub> и (TMBEDT-TTF)<sub>5</sub>Hg(SCN)<sub>4-x</sub>I<sub>x</sub> ( $x \sim 0.35$ ) (EDT-TTF и TMBEDT-TTF = этилендитио- и тетраметил(бисэтилендитио)-тетратиафульвалены). Они характеризуются квазиодномерным характером электронного движения, продольная и поперечная проводимости этих соединений носят полупроводниковый характер. Недавно нами

синтезировано новое семейство органических проводников [4] общей формулы  $\theta$ -(D)<sub>4</sub>*M*Br<sub>4</sub>(Solvent), D = BEDT-TTF, BETS; M = Hg, Cd, Co, Zn, Mn; Solvent =  $C_6 H_{6-n} X_n$  [4–6] или *o*-XC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH<sub>3</sub> [7], X = Cl, Br, в которых соседние проводящие слои отличаются направлением стопок. Особенностью этих соединений является разный характер температурной зависимости проводимости в кристалле: металлический в проводящих слоях и полупроводниковый перпендикулярно этим слоям [4]. При понижении температуры строение соседних проводящих слоев в таких проводниках становится различным, что позволило назвать их двухслойными квазидвумерными органическими проводниками [4]. Исследование таких электропроводящих катион-радикальных солей важно для понимания свойств соединений и природы электронных явлений в органических проводниках



Существенную информацию о состоянии электронной системы в электропроводящих органических катион-радикальных солях дает изучение поляризованных спектров отражения. В таких спектрах наблюдается высокое отражение в низкочастотной области с плазменным краем, характерное для металлов, а также проявляются эффекты, связанные с взаимодействием внутримолекулярных колебаний с электронами проводимости [8–10].

В настоящей работе изучены поляризованные спектры отражения и спектры оптической проводимости органических проводников  $\theta$ -(BEDT-TTF)<sub>4</sub>HgBr<sub>4</sub>(DCB) (1),  $\theta$ -(BEDT-TTF)<sub>4</sub>CdBr<sub>4</sub>(DBB) (2),  $\theta$ -(d<sub>8</sub>-BEDT-TTF)<sub>4</sub>CdBr<sub>4</sub>(DBB) (3),  $\theta$ -(BETS)<sub>4</sub>CdBr<sub>4</sub>(PhBr) (4) [DCB = 1,2-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Cl<sub>2</sub>, DBB = 1,2-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>] в спектральной области 700– 5500 см<sup>-1</sup> при комнатной температуре и рассмотрена их взаимосвязь с кристаллической структурой.

### ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Соединения 1, 2, 4 синтезированы описанным нами ранее методом [11–13], 3 получено электрохимическим окислением  $d_8$ -BEDT-TTF (6 мг, 0.015 ммоля) в 13 мл 1,2-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>Br<sub>2</sub>, содержащего 8% EtOH, при температуре 23°C и силе тока 0.2 мкА. В качестве электролита использован [Ph<sub>4</sub>P]<sub>2</sub>CdBr<sub>4</sub> (34 мг, 0.03 ммоля). Кристаллы, образовавшиеся в течение трех недель, промывали ацетоном, сушили на воздухе. Состав установлен рентгеноспектральным микроанализом.

Кристаллы 1–4 представляют собой прямоугольные или треугольные пластинки с гладкими зеркальными поверхностями с размером примерно 1 × 1.2 × 0.05 мм. Проводящие слои молекул BEDT-TTF или BETS в кристаллах 1–4 ориентированы параллельно наиболее развитой грани *ab*.

Поляризованные спектры отражения измерялись на фурье-спектрометре FT-IR Perkin-Elmer 1725Х, оснащенном инфракрасным микроскопом, с эффективным диаметром светового пучка 100 мкм. Разрешение  $-4 \text{ см}^{-1}$ , "golden wire" – поляризатор. Поляризованные спектры отражения при нормальном падении света на наиболее развитую грань кристалла измерены в интервале частот 700-5500 см<sup>-1</sup> при комнатной температуре. Спектры отражения 1-3 измерены в поляризациях, при которых электрический вектор световой волны Е направлен вдоль длинного ребра прямоугольного кристалла (E||a) и под углом 90° к длинному ребру этого кристалла ( $E \perp a$ ), что соответствует направлениям стопок BEDT-TTF в соседних слоях. Спектры отражения кристалла соединения 4, имеющего форму прямоугольного треугольника, измерены в поляризациях, при которых Е направлен вдоль гипотенузы и под углом ~105° к ней, при этом достигалась максимальная

анизотропия спектров. Форма кристалла и направления, вдоль которых снимались спектры **4**, показаны ниже. Точность установки кристалла в поле световой волны составляла 7–10°. Спектры оптической проводимости вычислены из спектров отражения с помощью преобразования Крамерса–Кронига.

#### ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Монокристаллы соединений 1, 2, 4 выращены по известным методикам [11, 12], соединение 3 получено впервые. При комнатной температуре все эти соединения изоструктурны и принадлежат к тетрагональной сингонии [11, 12]. Согласно принятой структурной классификации органических проводников на основе ион-радикальных солей, они относятся к θ-фазам [14] и характеризуются присутствием в проводящих слоях катион-радикальных стопок двух видов, А и В, построенных, соответственно, из независимых катион-радикалов А и В. В структурах 1-4 проводящие слои θ-типа, состоящие из катионрадикалов BEDT-TTF [11] или BETS [12], параллельны плоскости ab и разделены слоями из анионов  $[MBr_4]^{2-}$  и молекул растворителя. От обычных θ-фаз структуры 1-4 отличаются тем, что каждый последующий слой повернут относительно предыдущего на 90°. В элементарной ячейке 1-4 содержится четыре проводящих слоя, I, II, III и IV (рис. 1). В первом слое стопки направлены вдоль оси a, во втором — вдоль оси b (перпендикулярной а), в третьем слое – в направлении –а и в четвертом — в направлении -b. Таким образом, в соседних проводящих слоях направления стопок ортогональны и соединения 1-4 представляют собой проводники с различно ориентированными слоями.

В отдельно взятом проводящем слое соединений 1-4 стопки А и В различаются расстояниями между усредненными плоскостями катион-радикалов (~0.3 Å) и углом наклона катион-радикалов к оси стопки. В стопках обоих типов отсутствуют укороченные контакты халькоген....халькоген (S...S или Se...Se), тогда как между катион-радикалами из соседних стопок наблюдается большое число укороченных боковых контактов S...S или S...Se. Двугранный угол между катион-радикалами А и В составляет 104(1)° для 1-3 [11] и 105.1° для 4 [12]. При комнатной температуре 1–4 изоструктурны соединению  $\theta$ -(BETS)<sub>4</sub>HgBr<sub>4</sub>(PhCl). Ранее для этого соединения выполнены расчеты межмолекулярных интегралов перекрывания ВЗМО [15] вдоль стопок и между стопками в направлении боковых контактов. Показано, что интегралы перекрывания ВЗМО для единичного проводящего слоя варьируют в интервале (12.8-4.0)  $\times$  10<sup>-3</sup> в зависимости от направления в слое,



**Рис. 1.** Расположение катион-радикальных стопок в последовательно чередующихся проводящих слоях I, II, III, IV соединений **1–4**. Показана проекция вдоль длинной оси молекулы BEDT-TTF.

что предполагает квазидвумерный характер электронной структуры, с небольшой анизотропией. Интегралы перекрывания в стопках выше, чем между стопками, а интегралы перекрывания в направлении боковых контактов, параллельных катион-радикалам В. выше интегралов перекрывания в направлении боковых контактов, параллельных катион-радикалам А [15]. Параметры кристаллической решетки соединения θ- $(BETS)_4CdBr_4(PhBr)$ θ-(4) И соединения (BETS)<sub>4</sub>HgBr<sub>4</sub>(PhCl) близки (*a* = 9.764, *c* = 76.03 Å [12] и a = 9.774, c = 75.73 Å [15] соответственно), и для 4 можно ожидать близких значений интегралов перекрывания. Квазидвумерный характер металлической электронной системы внутри каждого проводящего слоя изоструктурных соединений 1-3 на основе BEDT-TTF был показан экспериментально [11, 16].

Электропроводность соединений 1-4 при комнатной температуре, измеренная вдоль проводящих слоев, равна 20, 15, 10 и 50 См·см<sup>-1</sup> для 1, 2, 3 и 4, соответственно, между слоями электропроводность составляет (2-5)  $\times$  10<sup>-3</sup> См·см<sup>-1</sup>. На рис. 2 показана температурная зависимость электрического сопротивления соединения 3 вдоль проводящих слоев и между слоями. При понижении температуры сопротивление 3, измеренное вдоль слоев, носит металлический характер до ~30 К, между слоями сопротивление имеет полупроводниковый характер. Аналогичное различие в поведении продольного и межслоевого сопротивления наблюдалось [11, 12] для 1, 2 и 4, причем в 1 и 4 металлический характер сопротивления вдоль слоев сохраняется вплоть до 4.2 К.

Поляризованные спектры отражения R(v) соединений 1–4 в интервале частот 700–5500 см<sup>-1</sup> представлены на рис. 3. Спектры отражения соединений 1–3 измерены от наиболее развитой проводящей грани кристалла в поляризациях, при которых электрический вектор световой волны Е параллелен кристаллографическим осям *a* и *b*. В силу особенностей кристаллической структуры обсуждаемых проводников, для каждой из этих поляризаций электрический вектор световой волны Е параллелен направлению стопок в половине проводящих слоев и перпендикулярен стопкам другой половины слоев (см. рис. 1).

В случае соединения **4** поляризованные спектры отражения измерены в поляризациях, при которых электрический вектор световой волны **E** параллелен диагонали (a-b) и направлен под углом ~105° к ней, что соответствует направлениям укороченных расстояний между катион-радикалами из соседних стопок. Когда **E**||(a-b), то в слоях I и III вектор **E** параллелен боковых контактам катион-радикала A, а в слоях II и IV отклоняется на угол 15° от направления боковых контактов B. Когда **E** образует угол ~105° с диагональю (a-b), то в слоях I и III вектор **E** параллелен направления боковых контактов B. Когда **E** образует угол ~105° с диагональю (a-b), то в слоях I и III вектор **E** параллелен направлению боковых контактов катион-радикала *B*, а в



**Рис. 2.** Металлический характер электрического сопротивления вдоль проводящих слоев (*1*) и полупроводниковый — перпендикулярно слоям (*2*) в кристалле  $\theta$ -(d<sub>8</sub>-BEDT-TTF)<sub>4</sub>CdBr<sub>4</sub>(DBB).



Рис. 3. Поляризованные спектры отражения кристаллов  $\theta$ -(BEDT-TTF)<sub>4</sub>HgBr<sub>4</sub>(DCB) (a),  $\theta$ -(BEDT-TTF)<sub>4</sub>CdBr<sub>4</sub>(DBB) (б),  $\theta$ -(d<sub>8</sub>-BEDT-TTF)<sub>4</sub>Cd-Br<sub>4</sub>(DBB) (в) и  $\theta$ -(BETS)<sub>4</sub>CdBr<sub>4</sub>(PhBr) (г): a-B - B поляризациях, параллельной (I) и перпендикулярной (2) кристаллографической оси a;  $\Gamma$  - B поляризации  $E \parallel (a-b) (2)$  и в поляризации, при которой E образует угол ~105° с диагональю a-b (I). На вставке: направления поляризации электрического вектора световой волны E для кристалла соединения 4.

слоях II и IV отклоняется на ~15° от направления боковых контактов А.

Отличительной особенностью соединений 1– 3 является сходство их спектров для двух ортогональных поляризаций (рис. 3). Различия между спектрами при этих поляризациях не превышают ошибку измерений (рис. 3а, 3б, 3в). Такая высокая степень оптической изотропии в проводящей плоскости связана с наложением оптического отклика от чередующихся проводящих слоев с ортогональным направлением стопок и ранее не наблюдалась в спектрах слоистых органических проводников на основе катион-радикальных солей. Для соединения **4** с BETS наблюдается небольшая анизотропия спектров отражения, что может быть связано с различием в интегралах перекрывания B3MO между катион-радикалами из соседних стопок для направлений, параллельных A и B. Подобная анизотропия R(v) ранее наблюдалась в  $\theta$ -(BETS)<sub>4</sub>HgBr<sub>4</sub>(PhCl) [15].

В спектрах отражения соединений 1–4 представленных на рис. 3, в низкочастотной части изученного диапазона наблюдается относительно высокое отражение до 0.5 для соединений BEDT-TTF 1–3 и до 0.7 для соединения 4 на основе BETS. В области 3000–5000 см<sup>-1</sup> во всех спектрах наблюдается плазменный край отражения с минимумом при 4300–4600 см<sup>-1</sup> для 1–3 и ~5500 см<sup>-1</sup> для 4. Такая спектральная зависимость отражения, близкая к друдевской, соответствует металлическому характеру электропроводности этих соединений.

В области внутримолекулярных колебаний BEDT-TTF и BETS на фоне друдевского отражения в обеих поляризациях наблюдаются колебательные особенности с несколькими сильно уширенными максимумами в интервале 820-1290 см<sup>-1</sup> для соединений 1-3 и с максимумами при 1353 и 1274 см<sup>-1</sup> для 4. Эти особенности обусловлены электронно-колебательным взаимодействием (ЭКВ), характерным для молекулярных проводников. Форма ЭКВ, наблюдаемая в спектрах соединений 1–3, типична для спектров кристаллов θ-фазы на основе молекулы BEDT-TTF [17]. В отличие от ранее изученных соединений  $\theta$ -фазы, особенности ЭКВ в спектрах соединений 1-3 изотропны в проводящей плоскости. Эта изотропия колебательных особенностей, также как и изотропия электронной составляющей спектра, обусловлена структурой соединений, где в соседних слоях стопки направлены под углом 90 градусов относительно друг друга.

Спектры соединений **1** и **2**, в основном, схожи по положению максимумов и лишь несколько отличаются по интенсивности отражения ( $\sim 8-9\%$ при 700 см<sup>-1</sup>). Это говорит о том, что небольшое варьирование анионного слоя в соединениях **1–2** (замена HgBr<sub>4</sub> на CdBr<sub>4</sub> и растворителя *o*-DCB на *o*-DBB) не оказывает существенного влияния на спектры отражения от проводящей плоскости соединений **1–2** при комнатной температуре.

Из рис. Зв видно, что в соединении **3** с дейтерированным BEDT-TTF несколько меняется форма ЭКВ, что связано со сдвигом частот колебаний, в которых принимают участие этиленовые группы молекулы BEDT-TTF [1, 18, 19].

Наибольшие изменения спектров отражения R(v) наблюдаются при замене BEDT-TTF на его Se-аналог, BETS (рис. 3г). В этом случае спектры

отражения меняются и по интенсивности, и по числу и положению максимумов в области ЭКВ. Более высокие значения отражения для этого соединения указывают на увеличение интегралов перекрывания между молекулами BETS по сравнению с BEDT-TTF. Это увеличение связано с тем, что больший радиус атома Se по сравнению с атомом S обеспечивает более сильное перекрывание B3MO катион-радикалов BETS и приводит также к большей стабильности металлического состояния в проводниках на основе BETS по сравнению с BEDT-TTF. Видно (рис. 3a-3r), что в спектре 4 особенности электронно-колебательной структуры выражены более резко, чем в 1-3.

Аналогичные 4 особенности спектров с близкими максимумами наблюдались ранее [20] для θ-(BETS)<sub>4</sub>HgBr<sub>4</sub>(PhCl). Было показано, что эти особенности появляются в результате взаимодействия носителей заряда: при 1353 см<sup>-1</sup> – с валентными колебаниями центральной и кольцевых С=С-связей v<sub>3</sub>(А<sub>*v*</sub>) ВЕТS; при 1274 см<sup>-1</sup> – с валентными колебаниями С-С-связей в этиленовых группах v<sub>5</sub>(A<sub>g</sub>) BETS [20]. Абсолютные значения R(v) для 4 ниже, чем для  $\theta$ -(BETS)<sub>4</sub>Hg-Br<sub>4</sub>(PhCl) примерно на 15%. Это коррелирует с более низкой электропроводностью соединения 4 (50 См см<sup>-1</sup>) по сравнению с электропроводностью  $\theta$ -(BETS)<sub>4</sub>HgBr<sub>4</sub>(PhCl) [15] (80 См см<sup>-1</sup>). Схолство спектров отражения соелинений  $\theta$ -(BETS)<sub>4</sub>CdBr<sub>4</sub>(PhBr) и θ-(BETS)<sub>4</sub>HgBr<sub>4</sub>(PhCl) показывает, что, как и в случае соединений BEDT-TTF. небольшое варьирование анионного слоя не оказывает сушественного влияния на отражение в области ЭКВ этих соединений при комнатной температуре.

Спектры оптической проводимости представлены на рис. 4. В спектрах оптической проводимости  $\sigma(v)$  соединений 1–4, в соответствии с металлическим типом спектров отражения, наибольпроводимости шие значения обеих ДЛЯ поляризаций наблюдаются при низких частотах, 700-1200 см<sup>-1</sup>. В области 1800-4500 см<sup>-1</sup> в спектрах оптической проводимости 1-4 наблюдается широкий максимум, в который вносят вклад электронные переходы, соответствующие процессу переноса заряда между молекулами BEDT-ТТF или BETS. В районе 1200-1300 см<sup>-1</sup> наблюдаются полосы, связанные с ЭКВ.

Положение электронных полос, отсутствие анизотропии и достаточно высокая оптическая проводимость **1–4**, более 200 См см<sup>-1</sup> при 700 см<sup>-1</sup>, указывают на металлический изотропный характер электронной системы данных соединений в двух направлениях проводящей плоскости.

Таким образом показано, что при комнатной температуре органические проводники  $\theta$ -(BEDT-TTF)<sub>4</sub>*M*Br<sub>4</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>X<sub>2</sub>) и  $\theta$ -(BETS)<sub>4</sub>*M*Br<sub>4</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>X) де-



Рис. 4. Спектры оптической проводимости соединений 1–4 (а–г): а–в – в поляризациях, параллельной (1) и перпендикулярной (2) кристаллографической оси a; г – в поляризации E||(a-b) (2) и в поляризации, при которой E образует угол ~105° с диагональю a-b(1).

монстрируют спектры отражения и оптической проводимости, типичные для этого типа соединений. Спектры свидетельствуют о металлической проводимости и вкладе межзонных переходов в электронную структуру. Характерной особенностью исследованных в этой работе соединений является высокая изотропия спектров в плоскости проводящих слоев. Она свидетельствует об изотропии электронной системы в проводящей плоскости и квазидвумерном характере электронного движения, что хорошо согласуется с кристаллической структурой, в которой слои с анизотропией чередуются с поворотом на 90 градусов, что приводит к отсутствию суммарной анизотропии соединения. Соединения 1–3 являются наиболее двумерно-изотропными среди описанных к настоящему времени органических проводников на основе ион-радикальных солей. Модифицирование анионного слоя в серии соединений  $\theta$ -(D)<sub>4</sub>*M*Br<sub>4</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>6-*n*</sub>X<sub>*n*</sub>) не оказывает существенного влияния на характер спектров при комнатной температуре.

Авторы выражают благодарность Р.М. Власовой и Б.В. Петрову за измерение спектров отражения соединений 1–3. Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 0089-2019-0011.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Williams J.M., Ferraro J.R., Thorn R.J., Carlson K.D., Geiser U., Wang H.H., Kini A.M., Whangbo M.H. Organic Superconductors (Including Fullerenes). Synthesis, Structure, Properties and Theory. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1992. 400 p.
- 2. *Dressel M.* // Crystals. 2018. V. 8. № 9. P. 332. https://doi.org/10.3390/cryst8090332
- Жиляева Е.И., Семкин В.Н., Юданова Е.И. и др. // Изв. АН. Сер. Хим. 2010. № 7. С. 1331.
- Lyubovskaya R., Zhilyaeva E., Shilov G. et al. // Eur. J. Inorg. Chem. 2014. P. 3820. https://doi.org/10.1002/ejic.201402041
- Zhilyaeva E.I., Shilov G.V., Torunova S.A. et al. // Cryst. Eng. Comm. 2014. V. 16. P. 10103. https://doi.org/10.1039/c4ce01440e
- Жиляева Е.И., Дзюба К.А., Флакина А.М. и др. // Изв. АН. Сер. Хим. 2013. № 7. С. 1636.
- Zhilyaeva E.I., Dzyuba K.A., Torunova S.A. et al. // Synth. Met. 2015. V. 209. P. 329. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2015.07.023

- 8. *Каплунов М.Г., Бородько Ю.Г. //* Химическая физика. 1987. Т. 6. С. 1529.
- 9. Власова Р.М., Дроздова О.О., Семкин В.Н. и др. // Физика твердого тела. 1999. Т. 41. № 5. С. 897.
- Dressel M., Drichko N. // Chem. Rev. 2004. V. 104. P. 5689. https://doi.org/10.1021/cr030642f
- Zhilyaeva E.I., Bogdanova O.A., Flakina A.M. et al. // Synth. Met. 2011. V. 161. P. 799. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2011.02.002
- 12. *Zhilyaeva E.I., Bogdanova O.A., Shilov G.V. et al.* // Synth. Met. 2009. V. 159. P. 1072. https://doi.org/10.1016/j.synthmet.2009.01.028
- Жиляева Е.И., Богданова О.А., Флакина А.М. и др. // Изв. АН. Сер. Хим. 2011. № 7. С. 1334.
- Mori T., Mori H., Tanaka S. // Bull. Chem. Soc. Japan. 1999. V. 72. P. 179. https://doi.org/10.1246/bcsj.72.179
- Lyubovskii R.B., Pesotskii S.I., Konovalikhin S.V. et al. // Synth. Met. 2001. V. 123. P. 149. https://doi.org/10.1016/S0379-6779(00)01381-3
- 16. Любовский Р.Б., Песоцкий С.И., Богданова О.А. и др. // Изв. АН. Сер. хим. 2011. № 7. С. 1340.
- Tajima H., Kyoden S., Mori H., Tanaka S. // Phys. Rev. B. 2000. V. 62. P. 9378 https://doi.org/10.1103/PhysRevB.62.9378
- Ferraro J.R., Wang H.H., Geiser U. et al. // Solid State Comm. 1988. V. 68. P. 917. https://doi.org/10.1016/0038-1098(88)90134-2
- Kornelsen K., Eldridge J., Wang H.H., Williams J.M. // Solid State Commun. 1990. V. 74. P. 501. https://doi.org/10.1016/0038-1098(90)90336-A
- Власова Р.М., Дричко Н.В., Петров Б.В. и др. // Физика твердого тела. 2002. Т. 44. С. 9.